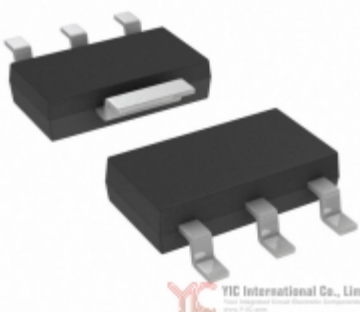

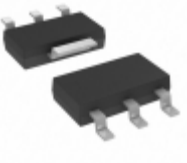
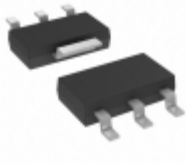



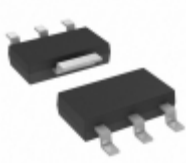

	<h2 style="color: #D9534F;">FDT86113LZ</h2> <p>Hersteller-Teilenummer: FDT86113LZ</p> <p>Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 100V 3.3A SOT223</p> <p>Datenblätter: 1.FDT86113LZ.pdf 2.FDT86113LZ.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 127381 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDT86113LZ
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 3.3A SOT223
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	127381 pcs Stock
Serie	PowerTrench®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-261-4, TO-261AA
Supplier Device-Gehäuse	SOT-223-4
Verlustleistung (max)	2.2W (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	3.3A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	100 mOhm @ 3.3A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	6.8nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	315pF @ 50V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

FDT86113LZ ist neu im Original, Suche FDT86113LZ Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDT86113LZ Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDT86113LZ: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 FDT86102LZ AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 6.6A SOT-223	 FDT86246L Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 2A SOT-223	 FDT86246 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 2A SOT-223	 FDT86113LZ AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 3.3A SOT223
 FDT86102LZ Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 6.6A SOT-223	 FDT86244 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 2.8A SOT-223	 FDT86106LZ AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 3.2A SOT-223-4	 FDT86244 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 2.8A SOT-223

heiße Teile

Mehr

⊗ ADC1175-50CIMT	↔ ADG211AKR	⇒ ADM812TART-REEL-7	D C0603X7R0J222M030BA	⇒ CGA3E2C0G2A151J080AA
⊣ F0503S-W1	⊗ F2405D-W25	D FDB024N04AL7	⇒ FDT1600N10ALZ	⇒ FDT1600N10ALZ
⊗ FDT3N40TF	⊣ FDT3N40TF	⊗ FDT434P-NL	↔ FDT439N-NL	⇒ FDT458P-NL
D FDT55AN06LA0	⊗ FDT55AN06LA0	⊣ FDT86102LZ	⊗ FDT86102LZ	⇒ FDT86106LZ
⇒ FDT86106LZ	↔ FDT86113LZ	⊗ FDT86244	⊣ FDT86244	⇒ FDT86246
↔ FDT86246	⇒ FDT86246L	D FDT86246L	⊗ FDT86256	⊣ FDT86256
⊗ GRM1556T1H6R5DD01D	D GRM21BR60J475KA11L	⇒ IR2135PBF	↔ IRG4PSC71K	⇒ J2-Q15A-B
⊣ LMTP33CA-786	⊗ LT1931AES5#TRPBF	↔ MAX8877EUK28+T	⇒ MMZ1608D301BTA00	⇒ N390CH30
⊗ PE40FC80	⊣ PTVS8V5S1UR	⊗ SI7892ADP-T1-GE3.	D SSC8620GSF	⇒ SV48-26W-200-4
↔ SW30CX595	⊗ TMJ107BB7104MAHT	⊣ UPA2709AGR-E2	⊗ V300C15C150B	⇒ WM8983GEFL/RVS

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited